

Germanium PNP Transistor

AD152

45V / 1A

DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1972/73

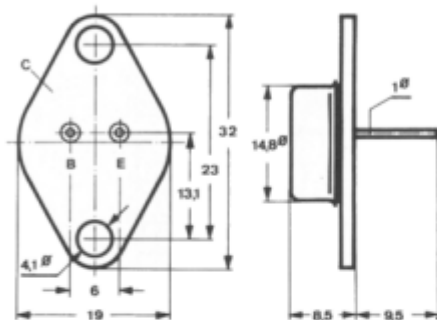
AD 152

Germanium-PNP-Transistor für NF-Endstufen und Leistungsverstärker. Als Transistorenpaar für Gegentaktendstufen.

Germanium PNP transistor for AF power stages and power amplifiers.
Matched pairs for push pull power stages.

Abmessungen · Dimensions

Maße in mm
M 1:1



Zubehör · Accessories

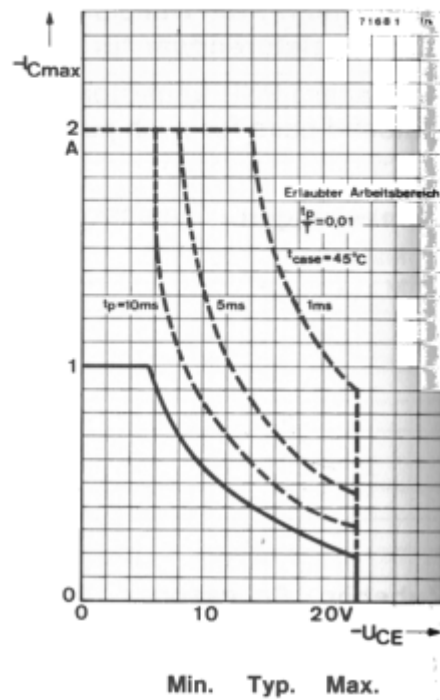
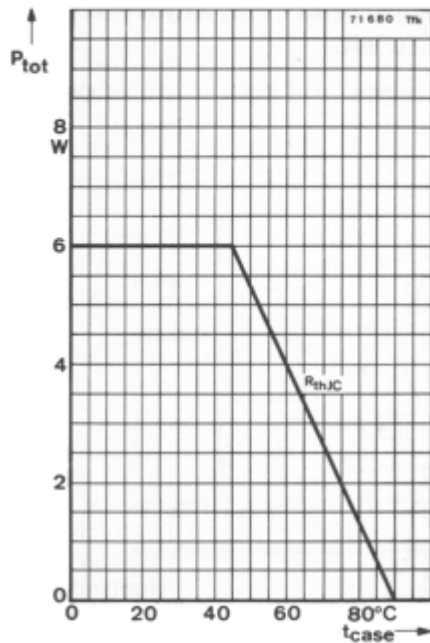
2×Isolierbuchse Best.-Nr. 009 005
2×Isolierbuchse Best.-Nr. 009 013
Isolierscheibe Best.-Nr. 009 014

Normgehäuse
DIN 9 A 2
SOT 9
Gewicht · Weight
max. 10 g

Absolute Grenzwerte · Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung	$-U_{CBO}$	45	V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung	$-U_{CEO}$	23	V
$R_{BE} \leq 500 \Omega$	$-U_{CER}$	45	V
Emitter-Basis-Sperrspannung	$-U_{EBO}$	12	V
Kollektorstrom	$-I_C$	1	A
Kollektorspitzenstrom	$-I_{CM}$	2	A
Gesamtverlustleistung			
$t_{case} \leq 45^\circ C$	P_{tot}	6	W
Sperrschichttemperatur	t_j	90	$^\circ C$
Lagerungstemperatur	t_{stg}	-55...+90	$^\circ C$

AD 152



Wärmewiderstand · Thermal resistance

Sperrschicht-Gehäuse R_{thJC} 7,5 °C/W

Kenngrößen · Characteristics

Umgebungstemperatur $t_{amb} = 25^\circ C$, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

$-U_{CB} = 6 V$	$-I_{CBO}$	20	μA
$-U_{CB} = 6 V, t_{amb} = 70^\circ C$	$-I_{CBO}$	500	μA
$-U_{CB} = 45 V$	$-I_{CBO}$	30	μA
$-U_{CE} = 45 V$	$-I_{CES}$	250	μA

Emitterreststrom

$-U_{EB} = 12 V$	$-I_{EBO}$	30	μA
------------------	------------	----	---------

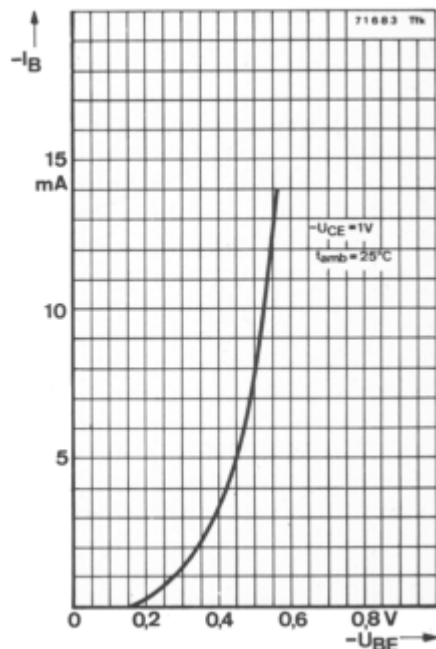
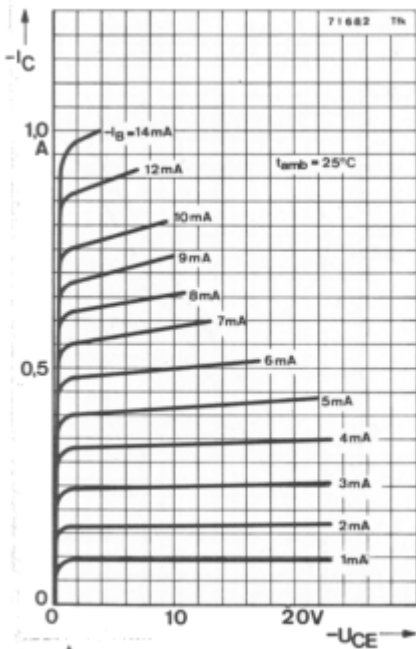
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

$-I_C = 2 A$	$-U_{(BR)CEO}^{1)}$	23	V
$-I_C = 1 mA, R_{BE} = 500 \Omega$	$-U_{(BR)CER}$	45	V

1) $\frac{t_p}{T} = 0,01, t_p = 0,3 ms$

AD 152

	Min.	Typ.	Max.	
Basisstrom				
-U _{CE} = 6 V, -I _C = 50 mA		0,6		mA
-U _{CE} = 1 V, -I _C = 500 mA		6,4	14,3	mA
-U _{CE} = 1 V, -I _C = 1 A		15		mA
Basis-Emitterspannung				
-U _{CE} = 10 V, -I _C = 10 mA		180		mV
-U _{CE} = 6 V, -I _C = 50 mA		240		mV
-U _{CE} = 1 V, -I _C = 500 mA		470		mV
Kollektor-Basis-Gleichstromverhältnis				
-U _{CE} = 6 V, -I _C = 50 mA		83		
-U _{CE} = 1 V, -I _C = 500 mA	35	78	160	
-U _{CE} = 1 V, -I _C = 1 A		66		
h_{FE}-Verhältnis				
für h _{FE 1} : -U _{CE} = 6 V, -I _C = 150 mA				
für h _{FE 2} : -U _{CE} = 2 V, -I _C = 1,5 A				
Für Paare gilt das h_{FE}-Verhältnis beider Transistoren¹⁾				
-U _{CE} = 1 V, -I _C = 500 mA, h _{FE} = 40...160			1,4	
h_{fe}-Grenzfrequenz				
-U _{CE} = 2 V, -I _C = 10 mA, t _{case} = 25°C		11		kHz



AD 152

